142500 г. Павловский Посад Московской обл., ул. Интернациональная, д.34а

Тел. 8-(49643)-2-31-07 www.okbexiton.ru E-mail: info@okbexiton.ru



1564ЛН9 ЭП

6 инверсных буферов с 3-мя состояниями и ТТЛ- входом.

Технология – КМОП 3мкм процесс.

Технические условия исполнения АЕЯР.431200.424-25ТУ.

Предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения.

Основные характеристики:

Диапазон напряжений питания от 4.5 B до 5.5 B.

Предельное напряжение питания до 7.0 В.

Диапазон рабочих температур от -60 °C до + 125 °C.

Время задержки распространения сигнала ≤ 30 нс при $U_{CC} = 4.5$ B, $C_L = 50$ pF, T = 25 °C.

Выходное напряжение низкого уровня ≤ 0.26 В при $U_{CC} = 5.5$ В, $I_0 = 7.8$ мА, T = 25 °C.

Выходное напряжение высокого уровня ≥ 4.98 В при $U_{CC} = 5.5$ В, $I_0 = 7.8$ мА, T = 25 °C.

Предельное знач. входного и выходного напряжений от -0.5 B до ($U_{CC} + 0.5$) B.

Стойкость к воздействию спецфакторов по группам исполнения:

 $7.И_1$ - $3У_C$, $7.И_6$ - $2У_C$, $7.И_7$ - $5У_C$, $7.C_1$ - $1У_C$, $7.C_4$ - $5У_C$, $7.K_1$ -1K, $7.K_4$ -1K для диапазона напряжения питания от 2 B до 6 B.

 $7.И_{1}$ - $3У_{C}$, $7.И_{6}$ - $2x5У_{C}$, $7.И_{7}$ - $5У_{C}$, $7.C_{1}$ - $4У_{C}$, $7.C_{4}$ - $5У_{C}$, $7.K_{1}$ -1K, $7.K_{4}$ -1K для диапазона напряжения питания от 3 B до 6 B.

Рис. 1. Условное графическое обозначение микросхем 1564ЛН9 ЭП.

Таблица 2. Таблица истинности микросхем 1564ЛН9 ЭП.

Вход D	Вход управления EZ	Выход Q
L	L	Н
Н	L	L
X	Н	Z

Таблица 1. Назначение выводов микросхем 1564ЛН9 ЭП.

	Tar	
№	Обозначение	Назначение вывода
вывода	вывода	пазна тепие вывода
1	1EZ	Вход управления
2	1D0	Вход
3	1Q0	Выход
4	1D1	Вход
5	1Q1	Выход
6	1D2	Вход
7	1Q2	Выход
8	0V	Общий
9	1Q3	Выход
10	1D3	Вход
11	2Q0	Выход
12	2D0	Вход
13	2Q1	Выход
14	2D1	Вход
15	2EZ	Вход управления
16	V_{CC}	Питание

Н - высокий уровень, L - низкий уровень,

Х - любое состояние, Z - третье состояние.

Таблица3. Электрические параметры микросхем 1564ЛН9 ЭП при приемке и поставке.

приемке и поставке.	1_	T		T
Наименование параметра,	Буквенное	Норма параметра		Темпера-
единица измерения,	обозначение			тура
режим измерения	параметра	не менее	не более	среды, °С
1. Максимальное выходное напряжение низкого				
уровня, В, при:	$U_{OL\;max}$		0.10	25±10,
$U_{CC} = 4.5 \text{ B}, U_{IL} = 0.8 \text{ B}, U_{IH} = 2.0 \text{ B}, I_{O} = 20 \text{ MKA}$		-	0.10	-60,
$U_{CC} = 5.5 \text{ B}, U_{IL} = 0.8 \text{ B}, U_{IH} = 2.0 \text{ B}, I_{O} = 20 \text{ MKA}$			0.10	125
			0.26	25±10
$U_{CC} = 4.5 \text{ B}, U_{IL} = 0.8 \text{ B}, U_{IH} = 2.0 \text{ B}, I_{O} = 6.0 \text{ mA}$		_	0.40	-60
			0.40	125
	_		0.26	25±10
$U_{CC} = 5.5 \text{ B}, U_{IL} = 0.8 \text{ B}, U_{IH} = 2.0 \text{ B}, I_{O} = 7.8 \text{ mA}$		_	0.40	-60
			0.40	125
2. Минимальное выходное напряжение высокого			0.10	123
уровня, В, при:	$ m U_{OH~min}$			
$U_{CC} = 4.5 \text{ B}, U_{IL} = 0.8 \text{ B}, I_{O} = 20 \text{ мкA}$	COHIIII	4.4	_	25±10,
	_	7.7		-60,
$U_{\rm CC} = 5.5~{ m B}, U_{\rm IL} = 0.8~{ m B}, I_{ m O} = 20~{ m mkA}$		5.4	_	125
- CCC - 3.3 B, CIL - 0.0 B, 10 - 20 MRT				
$U_{CC} = 4.5 \text{ B}, U_{IL} = 0.8 \text{ B}, I_{O} = 6.0 \text{ mA}$		3.98		25±10
C(C = 4.3 B, C _{IL} = 0.0 B, 10 = 0.0 Mr		3.7	-	-60
	_	3.7		125
$U_{CC} = 5.5 \text{ B}, U_{IL} = 0.8 \text{ B}, I_{O} = 7.8 \text{ mA}$		4.98		25±10
C(C = 3.3 B, C _{IL} = 0.0 B, 10 = 7.0 MT		4.70	-	-60
		4.70		125
3. Входной ток низкого уровня, мкА,			/ -0.1/	25±10
при: U _{CC} = 5.5 В,	$ m I_{IL}$	-	/ -0.1/	-60
$U_{IH} = U_{CC}, U_{IL} = 0 B$			/ -1.0/	125
4. Входной ток высокого уровня, мкА,			0.1	25±10
при: $U_{CC} = 5.5 B$,	$ m I_{IH}$	-	0.1	-60
$U_{IL} = 0 B, U_{IH} = U_{CC}$			1.0	125
5. Выходной ток в состоянии "Выключено", мкА,			0.5	25±10
при: $U_{CC} = 5.5 \text{ B}$, $U_{IL} = 0 \text{ B}$, $U_{IH} = U_{CC}$,	I_{OZ}	-	10.0	-60
$U_{O} = 0$, $U_{O} = U_{CC}$			10.0	125
6. Ток потребления ,мкА,			4.0	25±10
при: $U_{CC} = 5.5 B$,		-	160	-60
$U_{IL} = 0 \text{ B}, \ U_{IH} = U_{CC}, \ I_{O} = 0$			160	125
при: $U_{CC} = 5.5 B$,	$I_{\rm CC}$			25±10,
$U_{IL} = 0.4 \text{ B}, \ U_{IH} = 2.4 \text{ B}, \ I_{O} = 0$		-	4000	-60,
(для одного входа)				125
7. Динамический ток потребления, мА,				
при: $U_{CC} = 5.5 \text{ B}, \text{ f} = 10.0 \text{ M} \Gamma \text{ц}, \text{ C}_L = 0$	I_{OCC}	-	7.0	25±10
$U_{IL} = 0 B$, $U_{IH} = U_{CC}$				
8. Время задержки распространения сигнала			30	25±10
при включении и выключении, нс,	t_{PHL} ,		30	25±10
при: $U_{CC} = 4.5 \text{ B}, \ C_L = 50 \ \Pi\Phi$	$t_{\rm PLH}$	-	30	-60 125
$U_{IL} = 0 \text{ B}, \ U_{IH} = 3.0 \text{ B}$			30	125
			34	25±10
$U_{CC} = 4.5 \text{ B}, \ C_L = 150 \ \pi \Phi$		-	34	-60
$U_{IL} = 0 B, \ U_{IH} = 3.0 B$			34	125
9. Время перехода при включении и выключении,				
при: U _{CC} = 4.5 B,	$t_{\mathrm{THL}},$		12	25±10
$U_{IL} = 0 \text{ B}, U_{IH} = 3.0 \text{ B}$		_	18 18	-60 125
OL 02, OH 3.0 B	$t_{ m TLH}$		10	125

Продолжение таблицы 3.

			tilite rationi	
Наименование параметра,	Буквенное	Норма параметра		Темпера-
единица измерения,	обозначение			тура
режим измерения	параметра	не менее	не более	среды, °С
10. Время задержки распространения сигнала при переходе из состояния высокого и низкого уровня в третье состояние, нс,	$t_{ m PHZ}, \ t_{ m PLZ}$	-	44	25±10 -60
при: $U_{CC} = 4.5 \text{ B}, \ C_L = 50 \text{ п}\Phi, \ R = 1 \text{ кOm}$ $U_{IL} = 0 \text{ B}, \ U_{IH} = 3.0 \text{ B}$	VFLZ.		44	125
11. Время задержки распространения сигнала при переходе из третьего состояния в состоние высокого и низкого уровня, нс, при: $U_{CC} = 4.5$ B, $C_L = 50$ п Φ , $R = 1$ кOм $U_{IL} = 0$ B, $U_{IH} = 3.0$ B	t _{PZH} , t _{PZL}	-	48 48 48	25±10 -60 125
при: $U_{CC}=4.5~B,~C_L=150~\pi\Phi,~R=1~\kappa O_M$ $U_{IL}=0~B,~U_{IH}=3.0~B$		-	53 53 53	25±10 -60 125
12. Входная емкость, $\pi \Phi$, $\pi \rho U_{CC} = 0$ В	C_{I}	-	10	25±10

Т а б л и ц а 4. Предельно допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхем 1564ЛН9 ЭП.

Наименование	Буквен-	Норма параметра				Время	
параметра режима, единица измерения	ное обозна- чение	обозна-		предельный режим		воздействия предельного режима	
	пара- метра	не менее	не более	не менее	не более	эксплуатации	
Напряжение питания, В	U _{CC}	4.5	5.5	минус 0.5	7.0	_	
Входное напряжение, В	UI	0	Ucc	минус 0.5 минус 1.5	$U_{CC} + 0.5$ $U_{CC} + 1.5$	_	
Напряжение подаваемое на выход, В	Uo	0	Ucc	минус 1.5 минус 0.5	$U_{CC} + 1.5$ $U_{CC} + 0.5$	5 MC	
Ток через один любой вход, мА	I	_	_	_	20	-	
Ток через один любой выход, мА	I _O	_	7.8	_	25	_	
Ток постоянный (средний) через вывод V_{CC} и «общий», мА	$I_{\rm I}$	_	_	ŀ	50	-	
Рассеиваемая мощность, мВт	P _{tot}	_	_	_	4001)	_	
Длительность фронта и спада входного сигнала, нс, при: $U_{CC} = 2.0 \text{ B}$ $U_{CC} = 4.5 \text{ B}$	$ au_{\varphi}, au_{cn}$	_ _	$6^{2)}$ $6^{2)}$ $6^{2)}$	- -	1000 ³⁾ 500 ³⁾ 400 ³⁾	- -	
$U_{CC} = 6.0 \text{ B}$ Емкость нагрузки, пФ	C _L	_ _	50 ²)	_ _	500		

 $^{^{1)}}$ В диапазоне температур от минус 60 до 100 $^{\circ}$ С. В диапазоне температур от 100 до 125 $^{\circ}$ С норма снижается с коэффициентом 12 мВт /°С.

²⁾ При измерении динамических параметров.
³⁾ Динамические параметры не регламентируются.

Наработка микросхем до отказа T_H в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых TY исполнения, при температуре окружающей среды (температуре эксплуатации) не более (65+5) °C не менее 100000 ч, а в облегченном режиме: при $U_{CC}=4.5~\mathrm{B}\div5~\mathrm{B}$ - не менее $120000~\mathrm{v}$.

Масса микросхем: не более 1,7 г.

Варианты конструктивного исполнения для поставок заказчику:

- в корпусе типа 402.16-33.03 с золотым покрытием (1564ЛН9Т ЭП);
- в корпусе типа 402.16-33НБ с никелевым покрытием (1564ЛН9Т1 ЭП);
- кристаллы без корпуса и без выводов.

Возможно иное исполнение по требованиям Заказчика.

Обозначение микросхем при заказе (в договоре на поставку)

1564ЛН9Т ЭП – АЕЯР.431200.424-25ТУ.

При заказе микросхем, предназначенных для автоматической сборки (монтажа) аппаратуры, после обозначения ТУ ставят букву «А»:

1564ЛН9Т ЭП – АЕЯР.431200.424-25ТУ, А.

Обозначение микросхем при заказе в бескорпусном исполнении на общей пластине: 61564ЛH9-4 ЭП - AEЯP.431200.424-25TУ.

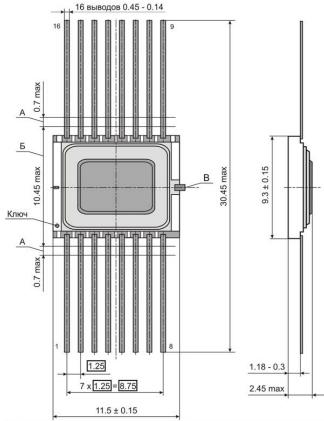


Рис. 2. Корпус 402.16-33 размеры в миллиметрах.

- А длина вывода, в пределах которой производится контроль смещения плоскостей симметрии выводов от номинального расположения.
- Б ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и часть выводов, непригодную для монтажа.
- В допускается поставка изделий без технологической перемычки В по согласованию с потребителями.

Для более полной информации о микросхеме использовать AEЯР.431200.424ТУ и AEЯР.431200.424-25ТУ, КСНЛ.431279.002ЭЗ, КСНЛ.431279.002ТБ1.